



产品特性 FEATURES

- ◆ 硅平面工艺结构 Planar technique
- ◆ 双向负阻性保护 Bidirectional crowbar protection
- ◆ 低漏电流 Low leakage current

最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25°C)

项目 Parameter	脉冲峰值电流 Repetitive peak pulse current	绝缘电阻 Insulation Resistance	工作结温 Operation Junction Temperature	存储温度 Storage Temperature
符号 Symbol	I _{PP}	R	T _J	T _{STG}
单位 Unit	A	Ω	°C	°C
额定值 Absolute Ratings	80 (10/1000μs)	1000M	-40~150	-40~150

芯片电特性 CHIP ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tc=25°C)

参数 Parameter	测试条件 Tests Conditions	最小值 Min.	典型值 Tye.	最大值 Max.	单位 Unit
不动作电压 V _{RM}	I _{RM} =2μA	6			V
最高限制电压 V _{BO}	100KV/s			15	V
通态电压 V _{TM}	I _T =1A			4	V
维持电流 I _H	10A, 10/1000μs	50			mA
极间电容 C	2V, 1MHz			65	pF
雷击残压 V _c	10/700μs 1KV			35	V
	10/700μs 2KV			45	V
	10/700μs 3KV			70	V
	10/700μs 4KV			85	V
	10/700μs 5KV			100	V

芯片信息 CHIP INFORMATION

圆片尺寸 Wafer Size	Φ4inch (100mm)		
芯片厚度 Chip Thickness	(180-200) μm		
芯片尺寸 Chip Size	A: 1.80mm×1.80mm		
金属 Metal	正面 Front	银 Ag	
	背面 Back	银 Ag	
键合区面积 Bond Area	B: 1.35mm×1.35mm		

附录 (Appendix) : 修订记录 (Revision History)

日期 Date	旧版本 Last Rev.	新版本 New Rev.	修订内容 Description of Changes
2012-12-27	201201A	201212B	按照客户要求增加雷击残压要求

